



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HA1962

对应国外型号
2SA1962

■ 主要用途

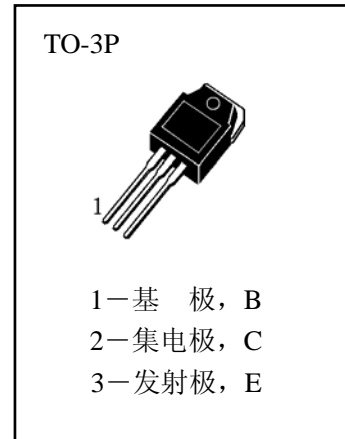
音频功率放大。与 HC5242 互补。

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg}	— 贮存温度	-55~150 $^\circ\text{C}$
T_j	— 结温	150 $^\circ\text{C}$
P_C	— 集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	130W
V_{CBO}	— 集电极—基极电压	-230V
V_{CEO}	— 集电极—发射极电压	-230V
V_{EBO}	— 发射极—基极电压	-5V
I_C	— 集电极电流 (DC)	-15A
I_C	— 集电极电流 (脉冲)	-30A
I_B	— 基极电流	-1.5A

■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

■ 外形图及引脚排列



参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-230			V	$I_C=-100\mu\text{A}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-230			V	$I_C=-50\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-5	μA	$V_{CB}=-230\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-5	μA	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	55		160		$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$
$H_{FE}(2)$		35				$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-7\text{A}$
V_{BE}	基极—发射极电压			-1.5	V	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-7\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		-1.5	-3	V	$I_C=-8\text{A}, I_B=-0.8\text{A}$
f_T	特征频率		30		MHz	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		360		pF	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$

■ HFE (1) 分档及其标志

R

0

55—110

80—160



典型特性曲线

